課題番号	:F-17-NM-0007
利用形態	:技術代行
利用課題名(日本語)	:グラフェンのバイオデバイス応用に向けたアミノ基修飾
Program Title (English)	: Amino group termination for wafer-scalable graphene bio-device
利用者名(日本語)	:斎藤達朗
Username (English)	: <u>T. Saito</u>
所属名(日本語)	:株式会社 東芝
Affiliation (English)	:Toshiba Corp.
キーワード/Keyword	:グラフェン、半導体プロセス、アミノ基修飾、リソグラフィ・露光・描画装置

### <u>1. 概要(Summary)</u>

次世代半導体デバイス候補の一つとしてグラフェンの バイオ応用を検討している。バイオ応用のためにはグラフ ェン表面にバイオ界面(バイオプローブや選択膜など)を 形成することがあり、様々なバイオ界面形成を可能とする ためには COOH や NH2、SH 等のたんぱく質等が有す る官能基をグラフェン表面に形成することが重要である。 本研究では、半導体ウエハプロセスと親和性の高い手法 でのグラフェン表面への NH2 修飾を検討した。

# <u>2. 実験(Experimental)</u>

# 【利用した主な装置】

- 125kV 電子ビーム描画装置
- ・ 高速マスクレス露光装置
- ・ マスクアライナー
- 12 連電子銃型蒸着装置
- ・ 多目的ドライエッチング装置
- ウエハ RTA 装置

### 【実験方法】

単層グラフェンは高温 CVD (Chemical vapor deposition)により成膜され SiO<sub>2</sub> 基板上に転写された市 販のものを使用した。NIMS 微細加工 PF を利用し、フォ トリソグラフィ、酸素ドライエッチングにより転写したグラフェ ンを短冊状に加工し、電子ビーム描画、金属蒸着、リフト オフによりグラフェン上に金属引き出し電極を形成した。 その後、自社にてグラフェン表面への NH<sub>2</sub> 修飾プラズマ 処理を行い、組成評価および電気特性評価を実施した。 <u>3. 結果と考察 (Results and Discussion)</u>

Fig.1にXPS分析によるNH2修飾を行ったグラフェン 表面の全体の原子に対する炭素原子の組成比と炭素原 子に対するNH2分子の組成比のプラズマ処理時間依存 性を示す。炭素の組成比は360秒処理前後で35at%か ら6at%まで低下した。また、炭素原子に対するNH2分

子の組成比は処理時間に大きく依存しない。このことから プロセス初期段階ではNH2修飾とグラフェンエッチングが 同時に進行し、グラフェン表面への NH2 修飾はすぐに平 衡に達し、長時間ではグラフェンエッチングのみが起きて いると考えられる。また、炭素と炭素に対する NH2の組成 比より炭素をすべてグラフェンに起因すると仮定すると処 理時間 10 秒での処理によりほぼグラフェンをエッチング すること無く、数 nm 領域に1つの NH2 基という十分な密 度のプローブ形成起点を形成できていると推定できる。次 に処理時間 10 秒処理での Id-Vg 特性の変化を Fig. 2 に 示す。プラズマ処理によりフェルミ点のゲート電圧は変化 しているが Id-Vg特性の傾きには大きな変化は見られない。 フェルミ点のゲート電圧は NH2 修飾によるグラフェンへの チャージの注入によるものと考えられる。本手法はバイオ 応用に向けた半導体プロセスと親和性の高い官能基修飾 法の一つとして期待できると考える。



### 4. その他・特記事項(Others)

謝辞:NIMS 微細加工 PF 津谷様、渡辺様、吉田様には 技術相談から技術支援・代行まで多大なる支援を頂き感 謝申し上げます。

5. 論文・学会発表(Publication/Presentation) なし。
6. 関連特許(Patent)

なし。